









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD80R1K0CEATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD80R1K0CEATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3
Datenblätter:	 IPD80R1K0CEATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80R1K0CEATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ CE
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 3.6A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	785pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A (Tc)

IPD80R1K0CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R1K0CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R1K0CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD80R1K0CEATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD80R1K4CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3</p>	 <p>IPD80N06S3-09 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO252-3</p>	 <p>IPD80R1K0CE INFINEO IPD80R1K0CE INFINEO</p>	 <p>IPD80P04P4L-08(4P04L08) INFINEO INFINEO TO-252</p>
 <p>IPD80R1K2P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 4.5A TO252-3</p>	 <p>IPD80R1K4CE INFINEO IPD80R1K4CE INFINEO</p>	 <p>IPD80R1K4CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3</p>	 <p>IPD80P03P4L-07 INFINEO IPD80P03P4L-07 INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD80R1K0CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD80R1K0CEATMA1 Datenblatt	IPD80R1K0CEATMA1-Datenblätter	IPD80R1K0CEATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R1K0CEATMA1
IPD80R1K0CEATMA1 Electronic	IPD80R1K0CEATMA1-Komponenten	IPD80R1K0CEATMA1-Verteiler	IPD80R1K0CEATMA1-Bild	IPD80R1K0CEATMA1-Teil
IPD80R1K0CEATMA1 Preis	IPD80R1K0CEATMA1 Hersteller	IPD80R1K0CEATMA1 Bild	IPD80R1K0CEATMA1 Aktie	IPD80R1K0CEATMA1 Inventar
IPD80R1K0CEATMA1 Neu	IPD80R1K0CEATMA1 Original	IPD80R1K0CEATMA1 garantiert	IPD80R1K0CEATMA1 RFQ	IPD80R1K0CEATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited